

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 27 年 2 月 19 日 (2015.2.19)

【公開番号】特開 2014-49595 (P2014-49595A)
 【公開日】平成 26 年 3 月 17 日 (2014.3.17)
 【年通号数】公開・登録公報 2014-014
 【出願番号】特願 2012-191088 (P2012-191088)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 33/32 (2010.01)

H 0 1 L 33/14 (2010.01)

H 0 1 L 21/205 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 33/00 1 8 6

H 0 1 L 33/00 1 5 0

H 0 1 L 21/205

【手続補正書】

【提出日】平成 26 年 12 月 24 日 (2014.12.24)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

n 型半導体よりなる電子供給層を有する窒化物半導体素子において、
 前記電子供給層は、

$A_{1-x}Ga_{1-x}N$ (但し、 $0.01 < x < 1$) の組成を有し、かつ、
 n 型不純物の濃度が $3 \times 10^{19} / \text{cm}^3$ 以上であり、

厚みが $0.5 \mu\text{m}$ 以上である

ことを特徴とする窒化物半導体素子。

【請求項 2】

前記 n 型不純物は、シリコン (Si) であることを特徴とする請求項 1 に記載の窒化物半導体素子。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0006

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0006】

本発明の窒化物半導体素子は、n 型半導体よりなる電子供給層を有する窒化物半導体素子において、

前記電子供給層は、

$A_{1-x}Ga_{1-x}N$ (但し、 $0.01 < x < 1$) の組成を有し、かつ、
 n 型不純物の濃度が $3 \times 10^{19} / \text{cm}^3$ 以上であり、

厚みが $0.5 \mu\text{m}$ 以上である

ことを特徴とする。